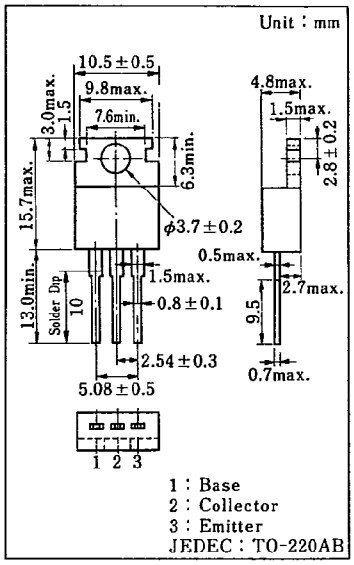
2SD804

シリコン NPN 三重拡散メサ形／Si NPN Triple Diffused Junction Mesa

電力増幅用／Power Amplifier



■ 特　徴／Feature

● コレクタ・エミッタ飽和電圧 $V_{CE(sat)}$ が低い。／Low $V_{CE(sat)}$

■ 絶対最大定格／Absolute Maximum Ratings (Ta=25 ℃)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	60	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	60	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	5	V
せん頭コレクタ電流	I_{CP}	4	A
コレクタ電流	I_C	3	A
ベース電流	I_B	1	A
コレクタ損失 (Tc=25 ℃)	P_C	25	W
接合部温度	T_j	150	℃
保存温度	T_{stg}	−55～+150	℃

■ 電気的特性／Electrical Characteristics (Ta=25 ℃)

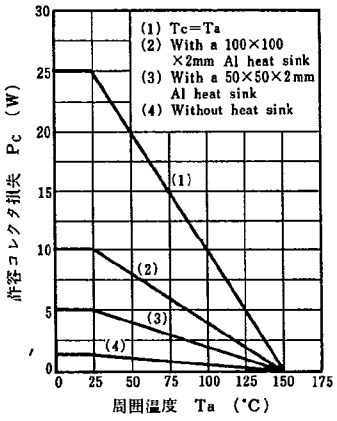
Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタしゃ断電流	I_{CBO}	V_{CB}=20 V, I_E=0			30	μA
エミッタしゃ断電流	I_{EBO}	V_{EB}=5 V, I_C=0			1	mA
コレクタ・エミッタ電圧	$V_{CEO(sus)}$	I_C−0.2 A, L−25 mH	60			V
直流電流増幅率	h_{FE1}	V_{CE}=3 V, I_C=0.1 A	40			
	h_{FE2}*	V_{CE}=3 V, I_C=1 A	30		160	
ベース・エミッタ電圧	V_{BE}	V_{CE}=3 V, I_C=1 A			1.4	V
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	I_C=2 A, I_B=0.4 A			1	V
しゃ断周波数	$f_{\alpha e}$	V_{CE}=10 V, I_C=0.2 A		70		kHz

* h_{FE2} ランク分類／h_{FE2} Classifications

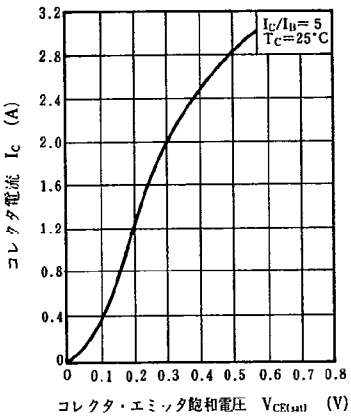
Class	Q	P	O
h_{FE2}	30～60	50～100	80～160

トランジスタ T-33-09 2SD804

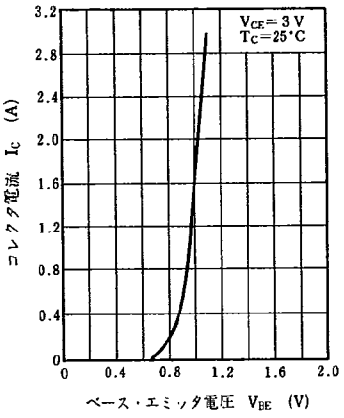
$P_C - T_a$



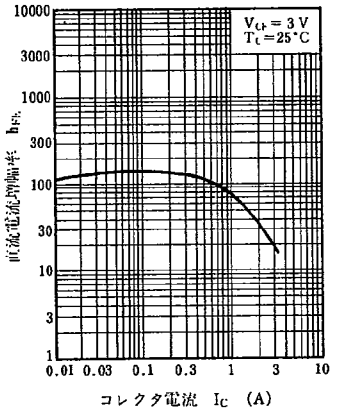
$I_C - V_{CE(sat)}$



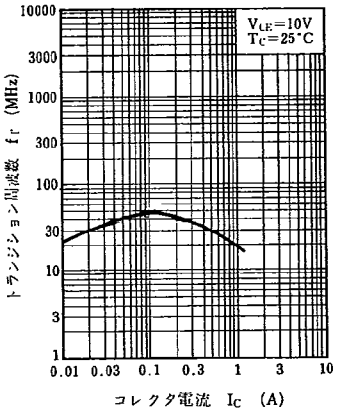
$I_C - V_{BE}$



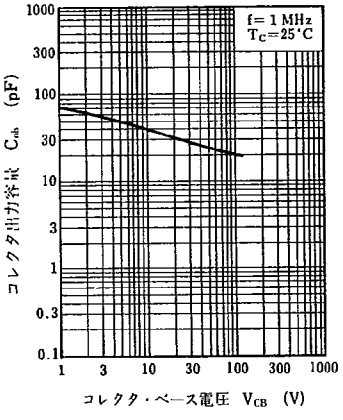
$h_{FE} - I_C$



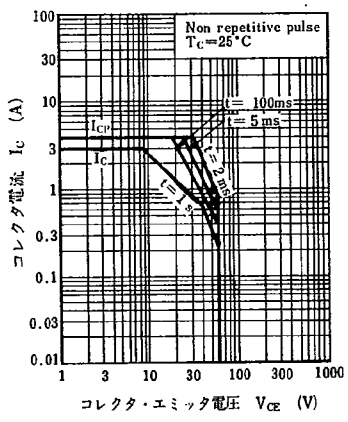
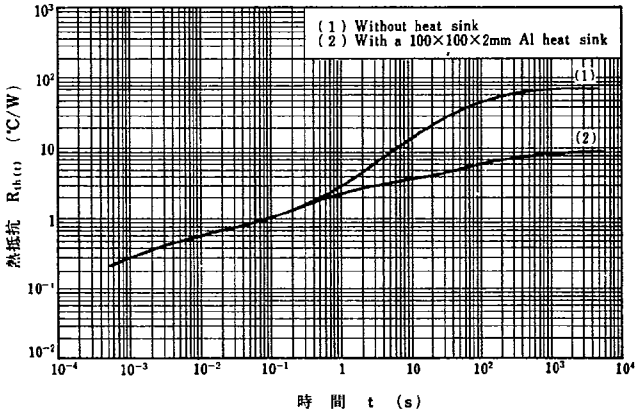
$f_T - I_C$



$C_{ob} - V_{CB}$



安全動作領域 ASO



$R_{th(t)} - t$